



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

**H649A**

对应国外型号  
2SB649A

### 主要用途

低频功率放大

### 极限值 ( $T_a=25$ )

$T_{stg}$	——贮存温度.....	-55~150
$T_j$	——结温.....	150
$P_C$	——集电极功率耗散 ( $T_c=25$ ) .....	20W
$P_C$	——集电极功率耗散 ( $T_A=25$ ) .....	1W
$V_{CBO}$	——集电极—基极电压.....	-180V
$V_{CEO}$	——集电极—发射极电压.....	-160V
$V_{EBO}$	——发射极—基极电压.....	-5V
$I_C$	——集电极电流.....	-1.5A

### 外形图及引脚排列



### 电参数 ( $T_a=25$ )

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
$BV_{CBO}$	集电极—基极击穿电压	-180			V	$I_C=-1mA, I_E=0$
$BV_{CEO}$	集电极—发射极击穿电压	-160			V	$I_C=-10mA, I_B=0$
$BV_{EBO}$	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-1mA, I_C=0$
$I_{CBO}$	集电极—基极截止电流			-10	$\mu A$	$V_{CB}=-160V, I_E=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	60		200		$V_{CE}=-5V, I_C=-150mA$
$H_{FE}(2)$	直流电流增益	30				$V_{CE}=-5V, I_C=-500mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			-1	V	$I_C=-500mA, I_B=-50mA$
$V_{BE}$	基极—发射极电压			-1.5	V	$V_{CE}=-5V, I_C=-150mA$
$f_T$	特征频率		140		MHz	$V_{CE}=-5V, I_C=-150mA$
$C_{ob}$	共基极输出电容		27		pF	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$

### 分档及其标志

B

C

60—120

100—200